



济南市半导体元件实验所

# 瞬态电压抑制二极管阵列系列产品

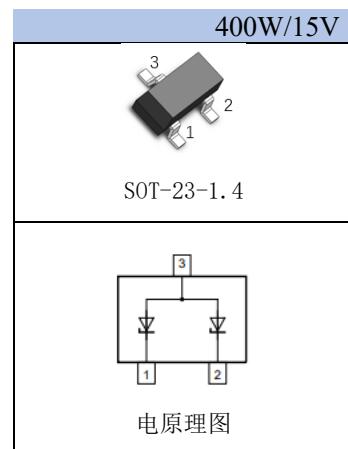
## ZL10D40S4P 型瞬态电压抑制二极管阵列

### 1 特性

- 芯片采用外延平面结构；
- 低电容，响应时间快，双通道；
- 重量 (mg): 9.4±1；
- 潮湿敏感度等级：3 级。

### 2 质量等级及执行标准

G 级: QZJ840611、Q/RBJ1016QZ	G+: Q/RBJ1016QZ、Q/RBJ-GL-02JS-04A
J 级: Q/RBJ-GL-02JS-01A	



### 3 最大额定值

单芯最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数 产品型号	$P_{PPM}$ $t_p=8/20 \mu\text{s}$ W	$I_{PP}$ $t_p=8/20 \mu\text{s}$ A	$V_{RWM}$ V	$T_{OP}$ °C	$T_j$ °C	$T_{STG}$ °C
ZL10D40S4P	400	10	15	-55~125	-55~150	-55~150

### 4 主要电特性

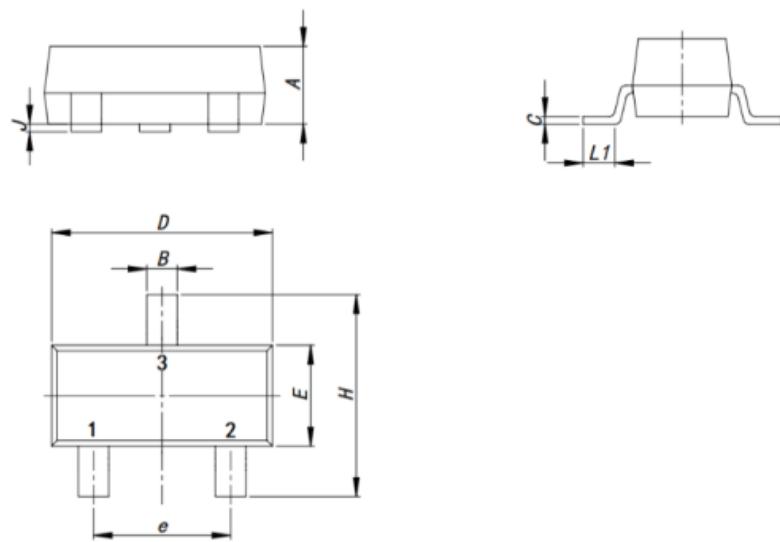
单芯主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数符号	测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
1	$V_{BR}$	$I_R=1\text{mA}$	16.7	—	20	V
2	$V_{C1}$	$I_{PP}=10\text{A}, t_p=8/20 \mu\text{s}$	—	—	40	V
3	$I_R$	$V_R=15\text{V}$	—	—	1.0	$\mu\text{A}$
4	$C_j$	$V_R=0, f=1\text{MHz}$	—	75	150	pF



## 5 外观尺寸



单位:mm

尺寸 符号	A	B	C	D	E	e	J	H	L1
最小值	0.79	0.30	0.05	2.70	1.07	1.70	-	2.22	0.16
最大值	1.19	0.50	0.25	3.10	1.47	2.10	0.184	2.62	0.36

图1 SOT-23-1.4 外形尺寸